











	RFD3055LE
	Hersteller-Teilenummer: RFD3055LE
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 11A I-PAK
Datenblätter:  RFD3055LE.pdf	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand: New original, 33660 pcs Stock Available.	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RFD3055LE
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 11A I-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33660 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 11A (Tc) 38W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Verlustleistung (max)	38W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	107 mOhm @ 8A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

RFD3055LE ist neu im Original, Suche RFD3055LE Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RFD3055LE AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RFD3055LE: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>RFD3055LESM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A TO-252AA</p>	 <p>RFD3055LE Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A I-PAK</p>	 <p>RFD3055 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12A IPAK</p>	 <p>RFD3055LESM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A TO-252AA</p>
 <p>RFD3055 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12A IPAK</p>	 <p>RFD22302 RF Digital MODULE RFDUINO SMT</p>	 <p>RFD3055L FAIRCHILD RFD3055L FAIRCHILD</p>	 <p>RFD22301-V3 RF Digital MODULE RFDUINO SMT</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ RFD16N03L	↔ RFD16N03LSM	⇒ RFD16N03LSM9A	D RFD16N05	↔ RFD16N05
⊣ RFD16N05L	⊗ RFD16N05LSM	D RFD16N05LSM	⇒ RFD16N05LSM-NL	↔ RFD16N05LSM96S5000
⊗ RFD16N05LSM9A	⊣ RFD16N05LSM9A	⊗ RFD16N05SM	↔ RFD16N05SM	↔ RFD16N05SM9A
D RFD16N05SM9A	⊗ RFD16N06	⊣ RFD16N06L	⊗ RFD16N06LESM	↔ RFD16N06LESM9A
⇒ RFD16N06LESM9A	↔ RFD16N06SM9A	⊗ RFD20N03SM	⊣ RFD20N03SM9A	↔ RFD3055L
↔ RFD3055LE	⇒ RFD3055LESM	D RFD3055LESM	⊗ RFD3055LESM9A	⊣ RFD3055LESM9A
⊗ RFD3055LESM9AS2568	D RFD3055RLESM96	⇒ RFD3055RLESM9A	↔ RFD3055SM	↔ RFD3055SM
⊣ RFD3055SM9A	⊗ RFD3055SM9A	↔ RFD4N06LSM	⇒ RFD8P05SM	↔ RFD8P05SM
⊗ RFD8P05SM9A	⊣ RFD8P06ESM	⊗ RFD8P06ESM9A	D RFD8P06LESM	↔ RFD8P06LESM9AR4407
↔ RFD8P06SM	⊗ RFD8P06TM	⊣ RFD8P06SM	⊗ RFD8P06TR13	↔ RFDIP1608060T1T

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited